

上海建桥学院教学进度安排表

2012 ~2013

学年度第 一 学期

课程名称：半导体器件物理

班级：电科 11B

总学时：64

日期	周次 星期	课 程 内 容			授课 方式	上课 地点	作业 布置
		章	节	内 容			
9.3	1/一	1	1~2	半导体晶体结构，半导体能带与杂质能级	讲课	2415	
9.7	1/五	1	3	半导体中平衡与非平衡载流子	讲课	2419	
9.10	2/一	1	~4	半导体中载流子的输运现象	讲课	2415	作业一
9.14	2/五	1	5	半导体表面	讲课	2419	
9.17	3/一	2	1	平衡 PN 结	讲课	2415	作业二
9.21	3/五	2	2	PN 结的直流特性	讲课	2419	
9.24	4/一	2	3~4	PN 结的击穿特性	讲课	2415	
9.28	4/五	2	5	PN 结的电容特性	讲课	2419	作业三
10.1	5/一					国庆放假	
10.5	5/五					国庆放假	
10.8	6/一	2	6, 7	PN 结的开关特性，金属-半导体的整流接触和欧姆接触	讲课	2415	
10.12	6/五				复习课	2419	
10.15	7/一				考试(1)		
10.19	7/五	3	1	晶体管的基本构造，制作工艺和杂质分布	讲课	2419	
10.22	8/一	3	1~2	晶体管的电流放大原理	讲课	2415	
10.26	8/五	3	3	晶体管的直流伏安特性曲线	讲课	2419	作业四
10.29	9/一	3	4, 5, 6	晶体管的反向电流和击穿特性，频率特性	讲课	2415	
11.2	9/五					11 级 期中考试	

11.5	10/一	3	6	晶体管的功率特性	讲课	2415	
11.9	10/五	3	7	晶体管的开关特性	讲课	2419	
11.12	11/一	4	~1	MOS 场效应管的结构, 工作原理和输出特性	讲课	2415	
11.16	11/五	4	~2	MOS 场效应管的阈值电压	讲课	2419	作业五
11.19	12/一	4	~3	MOS 场效应管的直流电流-电压特性	讲课	2415	
11.23	12/五	4	4~5	MOS 电容, MOS 场效应管的交流小信号参数	讲课	2419	
11.26	13/一	4	6	MOS 场效应晶体管的开关特性	讲课	2415	作业六
11.30	13/五	4	7	MOS 场效应晶体管的二级特性	讲课	2419	
12.3	14/一	4	8	MOS 场效应晶体管的温度特性	讲课	2415	
12.7	14/五	5	1	JFET 及 MESFET 的结构, 工作原理和分类	讲课	2419	
12.10	15/一	5	2	JFET 的电流-电压特性	讲课	2415	
12.14	15/五	6	1, 2	功能 MOS 场效应晶体管, IGBT	讲课	2419	
12.17	16/一	6	3	半导体光学效应及发光二极管	讲课	2415	
12.21	16/五	6	4	发光二极管,	讲课	2419	
12.24	17/一				复习课	2415	
12.28	17/五				考试		

注: 授课方式为讲课、实验、习题课、复习、考核, 不够写可续页。

任课教师: 张秋香
日期: 2012. 9. 1

系主任审核:
日期:

教学院长审核:
日期: